

(11) Publication number:

09321574 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 08133675

(51) Intl. Cl.: H03H 9/64 H01L 41/09 H03H 9/25

(22) Application date: **28.05.96**

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

12.12.97

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: FUJITSU LTD

(72) Inventor: UEDA MASANORI

ENDO TAKESHI KAWAUCHI OSAMU FUJIWARA YOSHIAKI

(74) Representative:

(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

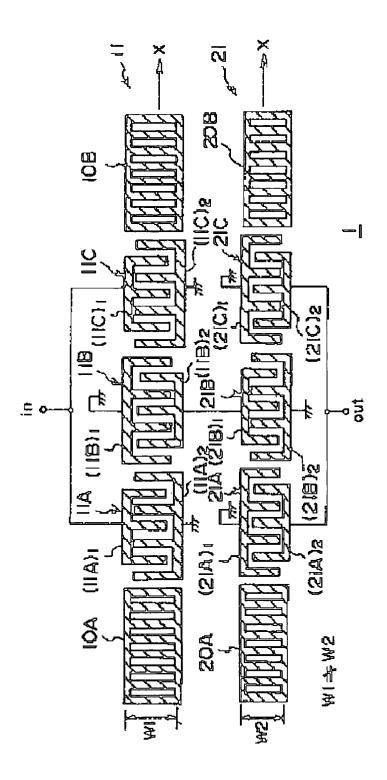
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To set freely input and output impedance by connecting a 1st surface acoustic wave element in cascade to a 2nd surface acoustic wave element and changing an electrode cross width of the 1st surface acoustic wave element with respect to the electrode cross width of the 2nd element.

SOLUTION: The device includes a SAW filter 11 consisting of reflectors 10A, 10B and interdigital electrodes 11A-11C arranged between the reflectors 10A, 10B and a SAW filter 21 consisting of reflectors 20A, 20B and interdigital electrodes 11A-11C arranged between the reflectors 20A, 20B. Then the SAW filters 11, 21 are connected in cascade by connecting a secondary electrode (11B)2 of the interdigital electrode 11B to a primary electrode (21B)2 of the interdigital electrode 21B. In this

case, the electrode crossing width of the SAW filter 21 is selected to be W2 (#W1) with respect to the electrode cross width W1 of the SAW filter 11, resulting that the entire input impedance of the SAW filter is set different from an output impedance.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-321574

(43)公開日 平成9年(1997)12月12日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所			
H03H 9/64		7259 – 5 J	H03H	9/64	2	Z		
H01L 41/09		7259 – 5 J		9/25	(2		
H 0 3 H 9/25		7259 – 5 J			A	A		
			H01L	41/08		С		
			審査請求	未請求	請求項の数17	OL	(全 18 頁)	
(21) 出願番号 特顯平8-133675			(71) 出題人 000005223					
				含土通	株式会社			
(22)出願日	平成8年(1996)5月28日			神奈川」	具川路市中原区 上	-小田中	94丁目1番	
				1号				
	•		(72)発明者	上田 3	攻 則			
			,	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番				
				1号 2	1号 富士通株式会社内			
			(72)発明者	遠遠	1 1)			
				神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番				
				1号 2	富士通株式会社内	3		
			(74)代理人	弁理士	伊京 忠彦			
						長	と終頁に続く	

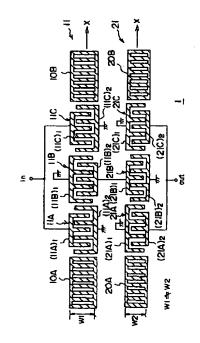
(54) 【発明の名称】 弾性表面波装置

(57) 【要約】

【課題】 スプリアスピークを抑圧した優れた通過帯域 特性を有し、入力インピーダンスと出力インピーダンス とを独立に設定可能なSAWフィルタを提供する。

【解決手段】 圧電基板上に複数のSAWフィルタをカスケード接続し、各々のSAWフィルタで電極交差幅を変化させる。さらに、二重モードフィルタにおいて、櫛形電極の電極対数を、中央の櫛形電極に対して非対称にする。

本発明の第2安施例による8AWフィルタの構成を示す図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電基板と、

前記圧電基板上に共通に形成され、各々が、前記圧電基板上に励起される弾性表面波の伝搬経路に沿って形成された一対の反射電極と、前記一対の反射電極の間に前記弾性表面波の伝搬経路に沿って形成された複数の櫛形電極とよりなる、少なくとも第1および第2の弾性表面波装置要素とよりなり、

前記複数の櫛形電極の各々は、各々前記圧電基板上において、前記弾性表面波の伝搬経路を第1の方向に横切る複数の、相互に平行な1次側電極指を含む1次側電極と、前記弾性表面波の伝搬経路を第2の逆方向に横切る複数の、相互に平行な2次側電極指を含む2次側電極とよりなり、前記複数の櫛形電極の各々において、前記複数の1次側電極指と前記複数の2次側電極指とは、前記伝搬経路に沿って交互に配列され、前記伝搬経路方向に沿って見た場合、所定の電極交差幅で互いに重量する構成の弾性表面波装置であって、

前記第1の弾性表面波装置要素において、前記複数の櫛 形電極は共通の第1の電極交差幅を有し、

前記第2の弾性表面波装置要素において、前記複数の櫛 形電極は共通の第2の、異なった電極交差幅を有し、

前記第1の弾性表面波装置要素は、前記第2の弾性表面 波装置要素に対して、前記第1の弾性表面波装置要素中 の一の櫛形電極の2次側電極を、前記第2の弾性表面波 装置要素中の対応する櫛形電極の1次側電極に接続する ことにより、カスケード接続されることを特徴とする弾 性表面波装置。

【請求項2】 前記第1の電極交差幅と、前記第2の電極交差幅とは、前記第1の弾性表面波装置要素の出力インピーダンスと前記第2の弾性表面波装置要素の入力インピーダンスとが整合するように設定されることを特徴とする請求項1記載の弾性表面波装置。

【請求項3】 前記第1の弾性表面波装置要素の出力インピーダンスと、前記第2の弾性表面波装置要素の入力インピーダンスとは、前記第1の弾性表面波装置要素の入力インピーダンスを2in,前記第2の弾性表面波装置要素の出力インピーダンスを2outとして、√(2in×2out)で与えられることを特徴とする請求項2記載の弾性表面波装置。

【請求項4】 前記第1および第2の弾性表面波装置要素の各々は、前記1対の反射電極の間に第1,第2および第3の櫛形電極を、前記複数の櫛形電極として順次配設した2重モード型弾性表面波装置であることを特徴とする請求項1~3のうち、いずれか一項記載の弾性表面波装置。

【請求項5】 前記第1の弾性表面波装置要素において、前記第1および第3の櫛形電極の1次側電極を、共通に入力電極パッドに接続し、

前記第2の弾性表面波装置要素において、前記第1およ 50 性表面波装置。

び第3の櫛形電極の2次側電極を、共通に出力電極パッ ドに接続し、

前記第1の弾性表面波装置要素の前記第2の櫛形電極の 2次側電極を、前記第2の弾性表面波装置要素の第2の 櫛形電極の1次側電極に接続したことを特徴とする請求 項4記載の弾性表面波装置。

【請求項6】 前記第1の弾性表面波装置要素において、前記第2の櫛形電極の1次側電極とを入力電極パッドに接続し、

7 前記第2の弾性表面波装置要素において、前記第2の櫛 形電極の2次側電極を出力電極パッドに接続し、

前記第1の弾性表面波装置要素の前記第1の櫛形電極の 2次側電極を、前記第2の弾性表面波装置要素の第1の 櫛形電極の1次側電極と接続し、

前記第1の弾性表面波装置要素の前記第3の櫛形電極の 2次側電極を、前記第2の弾性表面波装置要素の第3の 櫛形電極の1次側電極に接続したことを特徴とする請求 項4記載の弾性表面波装置。

【請求項7】 前記第1の弾性表面波装置要素におい 20 て、前記第1および第3の櫛形電極の1次側電極を、共 通に入力電極パッドに接続し、

前記第2の弾性表面波装置要素において、前記第2の櫛 形電極の2次側電極を出力電極パッドに接続し、

前記第1の弾性表面波装置要素の前記第2の櫛形電極の 2次側電極を、前記第2の弾性表面波装置要素の第1お よび第3の櫛形電極の1次側電極に共通に接続したこと を特徴とする請求項4記載の弾性表面波装置。

【請求項8】 前記第1および第2の弾性表面波装置要素の各々において、前記第1、第2および第3の櫛形電 30 極は、それぞれ互いに異なる第1,第2および第3の電極対数を有することを特徴とする請求項4~7のうち、いずれか一項記載の弾性表面波装置。

【請求項9】 圧電基板を支持するパッケージと、 前記圧電基板上に形成された少なくとも一つの弾性表面 波装置要素とよりなる弾性表面波装置であって、 前記弾性表面波装置は、前記圧電基板上に、弾性表面波 の伝搬経路に沿って形成された、入力側櫛形電極と出力

の伝搬経路に沿って形成された、人力側御形電極と出た 側櫛形電極とを少なくとも含む複数の櫛形電極よりなり、

40 前記入力側櫛形電極は、前記パッケージ上に設けられた 第1の接地電極パッドに接続され、

前記出力が櫛形電極は、前記パッケージ上に設けられた 第2の別の接地電極パッドに接続されることを特徴とす る弾性表面波装置。

【請求項10】 前記第1の接地電極バッドは、前記パッケージのうち、入力電極パッドが設けられる第1の側に設けられ、前記第2の接地電極パッドは、前記パッケージのうち、出力電極パッドが設けられる、反対側の第2の側に設けられることを特徴とする請求項9記載の弾

-2-

-

【請求項11】 前記パッケージは、さらに前記圧電基 板を覆う金属キャップを有し、前記金属キャップは、前 記第1および第2の接地電極パッドの一方にのみ接続さ れることを特徴とする請求項9または10記載の弾性表 面波装置。

【請求項12】 圧電基板と、

前記圧電基板上に、前記圧電基板上に励起される弾性表 面波の伝搬経路に沿って形成され、前記伝搬経路を規定 する第1および第2の反射電極と、

前記第1および第2の反射電極の間に順次配設された第 1, 第2および第3の櫛形電極とを含む二重モード型弾 性表面波装置において、

前記第1の櫛形電極の電極対数を、前記第3の櫛形電極 の電極対数に対して変化させたことを特徴とする弾性表 面波装置。

【請求項13】 前記第1の櫛形電極の電極対数をX, 前記第2の櫛形電極の電極対数をY,前記第3の櫛形電 極の電極対数をことして、X<Y<Zの関係が成立する ことを特徴とする請求項12記載の弾性表面波装置。

【請求項14】 圧電基板と、

前記圧電基板上に、前記圧電基板上に励起される弾性表 面波の伝搬経路に沿って形成され、前記伝搬経路を規定 する第1および第2の反射電極と、

前記第1および第2の反射電極の間に順次配設された複 数の櫛形電極とを含み、

各々の櫛形電極は、各々前記圧電基板上において、前記 弾性表面波の伝搬経路を第1の方向に横切る複数の、相 互に平行な1次側電極指を含む1次側電極と、前記弾性 表面波の伝搬経路を第2の逆方向に横切る複数の、相互 に平行な2次側電極指を含む2次側電極とよりなり、前 30 記複数の櫛形電極の各々において、前記複数の1次側電 極指と前記複数の2次側電極指とは、前記伝搬経路に沿 って交互に配列され、前記伝搬経路方向に沿って見た場 合、所定の電極交差幅で互いに重畳する構成の弾性表面 波装置において、

出力側電極または入力側電極を構成する複数の櫛形電極 が、前記2次側電極を相互接続することにより、カスケ ード接続されることを特徴とする弾性表面波装置。

【請求項15】 前記圧電基板は、回転角を40°Y~ 44°Yの範囲としたLiTaO3単結晶の回転Y板よ りなり、前記各々の櫛形電極はA1を主成分とする材料 より形成され、前記圧電基板上に励起される弾性表面波 の波長の5~10%の範囲の厚さを有することを特徴と する請求項1~14のうち、いずれか一項記載の弾性表 面波装置。

【請求項16】 前記圧電基板は、回転角を66°Y~ 74°Yの範囲としたLiNbO3単結晶の回転Y板よ りなり、前記各々の櫛形電極はAlを主成分とする材料 より形成され、前記圧電基板上に励起される弾性表面波 の波長の4~12%の範囲の厚さを有することを特徴と 50 (11B), は接地され、2次側電極 (11B), は出

する請求項1~14のうち、いずれか一項記載の弾性表 面波装置。

【請求項17】 圧電基板上に、前記圧電基板表面に励 起される弾性表面波の経路に沿って配設された複数の櫛 形電極よりなり、各々の櫛形電極が、複数の電極指を有 する1次側電極と、前記1次側電極指の複数の電極指に 対して交互に配列された別の複数の電極指を有する2次 側電極とよりなる弾性表面波装置において、

1次側電極が入/出力端子に接続された櫛形電極の2次 側電極は、別の入/出力端子に接続されることを特徴と する弾性表面波装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は一般に弾性表面波装 置に関し、特に帯域外減衰特性が向上し、また入力イン ピーダンスと出力インピーダンスとが、それぞれ所望の 設計値に設定された弾性表面波装置に関する。

[0002]

【従来の技術】弾性表面波 (SAW) 装置は、携帯電話 等、小型・軽量の超短波ないし極超短波帯域用無線装置 において、フィルタや共振器として広く使われている。 これらのフィルタや共振器では、広い通過帯域特性を有 すると同時に、帯域外での減衰量が非常に大きいことが 要求される。また、これらの弾性表面波装置を電子装置 において使う場合、電子装置を構成する集積回路装置と のインピーダンス整合をとる必要がある。

【0003】図19 (A), (B)は、従来の典型的な SAWフィルタを示す。図19(A)を参照するに、S AWフィルタはいわゆる二重モード型のSAWフィルタ であり、圧電基板 (図示せず) 上に形成された一対の反 射器10A, 10Bの間に三つの櫛形電極11A, 11 B, 11Cを備えている。図19の例では、基板は36 ° Y-XLiTaO3 単結晶板よりなり、反射器10 A, 10Bは基板のX軸方向に配列され、X軸方向に伝 搬する弾性表面波の経路を規定する。一方、各々の電極 11A, 11B, 11Cは、複数の一次側電極指を形成 された1次側電極 (11A):, (11B):, (11 C) / と、前記1次側電極指と対向する2次側電極指を 形成された2次側電極(11A)2 , (11B)2 ,

(11C)₂とよりなり、通常の櫛形電極と同様に、前 記1次側電極指と2次側電極指とは、前記X軸方向に交 互に配列され、前記弾性表面波の経路と交差する。その 際、電極指のピッチは、通過帯域の中心周波数および圧 電基板上をX軸方向に伝搬する弾性表面波の音速により

【0004】図19 (A) の構成では、電極11Aおよ び11Cの1次側電極 (11A), (11C); は入 力端子に接続され、また2次側電極(11A)2, (1 1 C) 2 は接地される。一方、電極11Bの1次側電極

5

力端子に接続される。すなわち、図19 (A) のSAW フィルタは、いわゆる2入力1出力型のSAWフィルタを構成する。

【0005】かかる二重モード型SAWフィルタでは、図19(B)に示すように、前記反射器10A,10Bの間に形成された周波数がf,の1次のモードと周波数がf3の3次のモードとを使い、図20に示すような、周波数f1とf3との間に通過帯域を有する通過帯域特性を実現する。ただし、図19(B)は、図19(A)の構造中における弾性表面波のエネルギ分布を示す。

【0006】従来は、前記1次のモードおよび3次のモードが対称的であることから、これら1次および3次のモードが効率的に励起されるように、前記櫛形電極11 $A\sim11C$ も対称的に構成され、その結果、従来の二重モード型SAWフィルタでは、前記電極11Aにおける電極指の対数 N_1 と、電極11Cにおける電極指の対数 N_3 とが互いに等しくなるように形成されていた。($N_1=N_3$)

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、図20の通過帯域特性では、周波数 f_1 , f_3 で規定される通過帯域外にも、大小様々なスプリアスピークが観測される。特に1550~1600MHz の範囲では、かかる通過帯域に隣接したスプリアスピークの存在により、急峻であるべき通過帯域特性がゆるやかになっているのがわかる。一方、SAWフィルタあるいは共振器では、通過帯域では平坦で、通過帯域外では急峻に減衰するような通過帯域特性を有するのが好ましい。また、通過帯域外では、減衰量は最大化できるのが好ましい。

【0008】また、図19(A)に示す従来のSAWフィルタでは、出力電極11Bと入力電極11A,11Cとで電極指の長さ、すなわち電極交差幅Wは必然的に等しくなり、その結果かかるSAWフィルタの入力インピーダンスと出力インピーダンスとの関係は、電極11A~11Cの電極対数で決まってしまう。一般にSAWフィルタの入出力インピーダンスは電極対数と電極交差幅に反比例する。すなわち、従来のSAWフィルタでは、入力インピーダンスと出力インピーダンスとを独立に、かつ自由に設定することが困難であった。これに対し、最近の携帯電話等の小型無線装置では、SAWフィルタの入出力インピーダンスを、かかる無線装置で使われる集積回路装置のインピーダンスに合わせて自在に設定できることが要望されている。

【0009】そこで、本発明は、上記の課題を解決した、新規で有用な弾性表面波装置を提供することを概括的課題とする。本発明のより具体的な課題は、通過帯域外におけるスプリアスピークを抑圧した、急峻な通過帯域特性を有する弾性表面波装置を提供することにある。

【0010】本発明の別の課題は、入力インピーダンス 電極パッドに接続し、前記第2の弾性表面波装置要素(と出力インピーダンスとを、容易に所望の設計値に設定 50 おいて、前記第1および第3の櫛形電極の2次側電極

できる構成の弾性表面波装置を提供することにある。 【0011】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の課題 を、請求項1に記載したように、圧電基板と、前記圧電 基板上に共通に形成され、各々が、前記圧電基板上に励 起される弾性表面波の伝搬経路に沿って形成された一対 の反射電極と、前記一対の反射電極の間に前記弾性表面 波の伝搬経路に沿って形成された複数の櫛形電極とより なる、少なくとも第1および第2の弾性表面波装置要素 とよりなり、前記複数の櫛形電極の各々は、各々前記圧 電基板上において、前記弾性表面波の伝搬経路を第1の 方向に横切る複数の、相互に平行な1次側電極指を含む 1次側電極と、前記弾性表面波の伝搬経路を第2の逆方 向に横切る複数の、相互に平行な2次側電極指を含む2 次側電極とよりなり、前記複数の櫛形電極の各々におい て、前記複数の1次側電極指と前記複数の2次側電極指 とは、前記伝搬経路に沿って交互に配列され、前記伝搬 経路方向に沿って見た場合、所定の電極交差幅で互いに 重畳する構成の弾性表面波装置であって、前記第1の弾 性表面波装置要素において、前記複数の櫛形電極は共通 の第1の電極交差幅を有し、前記第2の弾性表面波装置 要素において、前記複数の櫛形電極は共通の第2の、異 なった電極交差幅を有し、前記第1の弾性表面波装置要 素は、前記第2の弾性表面波装置要素に対して、前記第 1の弾性表面波装置要素中の一の櫛形電極の2次側電極 を、前記第2の弾性表面波装置要素中の対応する櫛形電 極の1次側電極に接続することにより、カスケード接続 されることを特徴とする弾性表面波装置により、または 請求項2に記載したように、前記第1の電極交差幅と、 前記第2の電極交差幅とは、前記第1の弾性表面波装置 要素の出力インピーダンスと前記第2の弾性表面波装置 要素の入力インピーダンスとが整合するように設定され ることを特徴とする請求項1記載の弾性表面波装置によ り、または請求項3に記載したように、前記第1の弾性 表面波装置要素の出力インピーダンスと、前記第2の弾 性表面波装置要素の入力インピーダンスとは、前記第1 の弾性表面波装置要素の入力インピーダンスをZin,前 記第2の弾性表面波装置要素の出力インピーダンスを2 out として、√(Zin×Zout)で与えられることを特 徴とする請求項2記載の弾性表面波装置により、または 請求項4に記載したように、前記第1および第2の弾性 表面波装置要素の各々は、前記1対の反射電極の間に第 1, 第2および第3の櫛形電極を、前記複数の櫛形電極 として順次配設した2重モード型弾性表面波装置である ことを特徴とする請求項1~3のうち、いずれか一項記 載の弾性表面波装置により、または請求項5に記載した ように、前記第1の弾性表面波装置要素において、前記 第1および第3の櫛形電極の1次側電極を、共通に入力 電極パッドに接続し、前記第2の弾性表面波装置要素に

20

を、共通に出力電極パッドに接続し、前記第1の弾性表 面波装置要素の前記第2の櫛形電極の2次側電極を、前 記第2の弾性表面波装置要素の第2の櫛形電極の1次側 電極に接続したことを特徴とする請求項4記載の弾性表 面波装置により、または請求項6に記載したように、前 記第1の弾性表面波装置要素において、前記第2の櫛形 電極の1次側電極とを入力電極パッドに接続し、前記第 2の弾性表面波装置要素において、前記第2の櫛形電極 の2次側電極を出力電極パッドに接続し、前記第1の弾 性表面波装置要素の前記第1の櫛形電極の2次側電極 を、前記第2の弾性表面波装置要素の第1の櫛形電極の 1次側電極と接続し、前記第1の弾性表面波装置要素の 前記第3の櫛形電極の2次側電極を、前記第2の弾性表 面波装置要素の第3の櫛形電極の1次側電極に接続した ことを特徴とする請求項4記載の弾性表面波装置によ り、または請求項7に記載したように、前記第1の弾性 表面波装置要素において、前記第1および第3の櫛形電 極の1次側電極を、共通に入力電極パッドに接続し、前 記第2の弾性表面波装置要素において、前記第2の櫛形 電極の2次側電極を出力電極パッドに接続し、前記第1 の弾性表面波装置要素の前記第2の櫛形電極の2次側電 極を、前記第2の弾性表面波装置要素の第1および第3 の櫛形電極の1次側電極に共通に接続したことを特徴と する請求項4記載の弾性表面波装置により、または請求 項8に記載したように、前記第1および第2の弾性表面 波装置要素の各々において、前記第1、第2および第3 の櫛形電極は、それぞれ互いに異なる第1, 第2および 第3の電極対数を有することを特徴とする請求項4~7 のうち、いずれか一項記載の弾性表面波装置により、ま たは請求項9に記載したように、圧電基板を支持するパ ッケージと、前記圧電基板上に形成された少なくとも一 つの弾性表面波装置要素とよりなる弾性表面波装置であ って、前記弾性表面波装置は、前記圧電基板上に、弾性 表面波の伝搬経路に沿って形成された、入力側櫛形電極 と出力側櫛形電極とを少なくとも含む複数の櫛形電極よ りなり、前記入力側櫛形電極は、前記パッケージ上に設 けられた第1の接地電極パッドに接続され、前記出力が 櫛形電極は、前記パッケージ上に設けられた第2の別の 接地電極パッドに接続されることを特徴とする弾性表面 波装置により、または請求項10に記載したように、前 記第1の接地電極パッドは、前記パッケージのうち、入 力電極パッドが設けられる第1の側に設けられ、前記第 2の接地電極パッドは、前記パッケージのうち、出力電 極パッドが設けられる、反対側の第2の側に設けられる

ことを特徴とする請求項9記載の弾性表面波装置によ

り、または請求項11に記載したように、前記パッケー

ジは、さらに前記圧電基板を覆う金属キャップを有し、

前記金属キャップは、前記第1および第2の接地電極パ

ッドの一方にのみ接続されることを特徴とする請求項9

または10記載の弾性表面波装置、または請求項12に

記載したように、圧電基板と、前記圧電基板上に、前記 圧電基板上に励起される弾性表面波の伝搬経路に沿って 形成され、前記伝搬経路を規定する第1および第2の反 射電極と、前記第1および第2の反射電極の間に順次配 設された第1,第2および第3の櫛形電極とを含む二重 モード型弾性表面波装置において、前記第1の櫛形電極 の電極対数を、前記第3の櫛形電極の電極対数に対して 変化させたことを特徴とする弾性表面波装置により、ま たは請求項13に記載したように、前記第1の櫛形電極 の電極対数をX, 前記第2の櫛形電極の電極対数をY, 前記第3の櫛形電極の電極対数をZとして、X<Y<Z の関係が成立することを特徴とする請求項12記載の弾 性表面波装置により、または請求項14に記載したよう に、圧電基板と、前記圧電基板上に、前記圧電基板上に 励起される弾性表面波の伝搬経路に沿って形成され、前 記伝搬経路を規定する第1および第2の反射電極と、前 記第1および第2の反射電極の間に順次配設された複数 の櫛形電極とを含み、各々の櫛形電極は、各々前記圧電 基板上において、前記弾性表面波の伝搬経路を第1の方 向に横切る複数の、相互に平行な1次側電極指を含む1 次側電極と、前記弾性表面波の伝搬経路を第2の逆方向 に横切る複数の、相互に平行な2次側電極指を含む2次 側電極とよりなり、前記複数の櫛形電極の各々におい て、前記複数の1次側電極指と前記複数の2次側電極指 とは、前記伝搬経路に沿って交互に配列され、前記伝搬 経路方向に沿って見た場合、所定の電極交差幅で互いに 重畳する構成の弾性表面波装置において、出力側電極ま たは入力側電極を構成する複数の櫛形電極が、前記2次 側電極を相互接続することにより、カスケード接続され ることを特徴とする弾性表面波装置により、または請求 項15に記載したように、前記圧電基板は、回転角を4 O°Y~44°Yの範囲としたLiTaO3 単結晶の回 転Y板よりなり、前記各々の櫛形電極はAIを主成分と する材料より形成され、前記圧電基板上に励起される弾 性表面波の波長の5~10%の範囲の厚さを有すること を特徴とする請求項1~14のうち、いずれか一項記載 の弾性表面波装置により、または請求項16に記載した ように、前記圧電基板は、回転角を66°Y~74°Y の範囲としたLiNbO3 単結晶の回転Y板よりなり、 前記各々の櫛形電極はAlを主成分とする材料より形成 され、前記圧電基板上に励起される弾性表面波の波長の 4~12%の範囲の厚さを有することを特徴とする請求 項1~14のうち、いずれか一項記載の弾性表面波装置 により、または請求項17に記載したように、圧電基板 上に、前記圧電基板表面に励起される弾性表面波の経路 に沿って配設された複数の櫛形電極よりなり、各々の櫛 形電極が、複数の電極指を有する1次側電極と、前記1 次側電極指の複数の電極指に対して交互に配列された別 の複数の電極指を有する2次側電極とよりなる弾性表面 波装置において、1次側電極が入/出力端子に接続され

50

た櫛形電極の2次側電極は、別の入/出力端子に接続されることを特徴とする弾性表面波装置により、解決する。

Q

【0012】図1は、本発明の第1の特徴を示す図である。図1を参照するに、SAWフィルタは図19(A)に示したものと同様な二重モード型の装置であるが、本発明では、櫛形電極11Aの電極対数 N_1 と櫛形電極11Bの電極対数 N_2 を相互に異ならせてあることがわかる($N_1 \neq N_3 \neq N_2$)。

【0013】図2は、図1のSAW74N9の周波数特性の計算結果を示す。ただし、図2中、実線で示した特性曲線は、図20の特性曲線に対応し、電極対数 N_1 , N_2 , N_3 を、それぞれ20, 40, 20とした場合をあらわす。一方、図2中、破線で示した曲線は、電極対数 N_1 , N_2 , N_3 をそれぞれ25, 35, 45とした場合を、また点線で示した曲線は、電極対数 N_1 , N_2 , N_3 をそれぞれ20, 40, 30とした場合をあらわす。ただし、図20計算では、圧電基板として36 $^{\circ}$ Y-XL $_1$ TaO $_3$ を仮定し、基板表面に形成された 20 櫛形電極11A \sim 11Cは、弾性表面波の波長08%の

厚さを有するAl電極より形成されていると仮定した。

【0014】本発明の発明者は、かかる計算により、電極対数N1,N3を非対称にした場合、帯域外スプリアスピークの高さが著しく減少することを見出した。かかる帯域外スプリアスピークの抑圧が生じる理由は十分に解明されているわけではないが、図1の構成では、電極11Aと11Cとが中央の電極11Bに対して非対称になるため、電極11Aで励起された後、反射器10Aで反射されて電極11Bに戻ってくる波と、電極11Cで励起された後、反射器10Bで反射されて電極11Bに戻ってくる波とが互いに打ち消し合い、その結果、図20に示したような帯域外のスプリアスピークが消滅するものと考えられる。

【0015】本発明の第2の特徴によれば、圧電基板上 に形成された第1の弾性表面波装置の電極交差幅に対し て、同じ圧電基板上に形成され、前記第1の弾性表面波 装置にカスケード接続された第2の弾性表面波装置の電 極交差幅を変えることにより、フィルタの周波数特性に 影響を及ぼす櫛形電極のピッチを変えることなく、入力 側SAWフィルタの入力インピーダンスと、出力側SA Wフィルタの出力インピーダンスとを、回路設計上の要 求に従って、自在に、かつ独立に設定することが可能に なる。また、このように複数のSAWフィルタをカスケ ード接続することにより、通過帯域内レベルに対して帯 域外レベルを、1段のみのSAWフィルタの場合に対し て下げることが可能になり、SAWフィルタの選択度を 向上させることができる。すなわち、本発明により、通 過帯域外のスプリアスピークを抑圧することが可能にな る。また、入力インピーダンスに対する出力インピーダ ンスの比を、単一段では不可能な非常に大きな値に設定 することができる。

【0016】また、このようなSAWフィルタを多段接続する場合、一の段のSAWフィルタの出力インピーダンスを次段のSAWフィルタの入力インピーダンスに整合させる必要があるが、その場合、前記一の段のSAWフィルタの入力インピーダンスZ1と出力インピーダンスZ2、および前記次段のSAWフィルタの入力インピーダンスZ3と出力インピーダンスZ3と出力インピーダンスZ4との間には、前記一の段のSAWフィルタと前記次段のSAWフィルタとが電極交差幅を除き、実質的に同一構成を有する場合、次の関係式が成立する。

【0017】 Z_1 : $Z_2 = Z_3$: Z_4 一方、前記インピーダンス整合の条件より、 Z_2 と Z_3 との間には、 $Z_2 = Z_3$ が成立しなければならない。そ の結果、前記出力インピーダンス Z_2 および入力インピーダンス Z_3 は、多段S AW Z_4 により、関係式 $Z_2 = Z_3 = \sqrt{(Z_1 \times Z_4)}$ で与えられる。

[0018]

【発明の実施の形態】まず、本発明の第1実施例を、先に説明した図1、および図3、図4を参照しながら説明する。図3を参照するに、この図は、図1に示した構造を、実際に42° $Y-XLiTaO_3$ 基板上に形成した、本発明の第1実施例によるSAWフィルタ11の周波数特性を示す。ただし、図3の例では、電極対数 N_1 , N_2 , N_3 を20:40:30とし、また電極11 $A\sim11C$ は、基板上に励起される弾性表面波の波長の6%の厚さを有するA1電極より形成している。

【0019】一方、図4は、図19に示した従来の構造において、基板に 42° Y-XL i T a O3 を使い、電極対数 N_1 , N_2 , N_3 を21:35:21 とした場合の周波数特性を示す。ただし、電極は、図3の場合と同様に、弾性表面波の波長の6%の厚さのA1電極より構成している。

【0020】図3,4を参照するに、図4の従来の周波数特性において、通過帯域の低周波側に出現していた顕著なスプリアスピークが、図3の周波数特性ではほとんど消滅していることがわかる。また、図3の周波数特性では、通過帯域の高周波側のスプリアスピークも抑圧されている。

【0021】本実施例によるSAWフィルタ11は特に GHz 帯での使用を念頭においたものであるが、このような超高周波帯域で使われるSAWフィルタでは、圧電 基板上の櫛形電極の厚さが励起される弾性表面波の波長 に対して無視できなくなり、その結果生じる付加質量の 効果により、圧電基板として使われているLiTaOs 単結晶板の最適カット角が、従来の36°Yよりも高角 度側にずれる。かかる電極の付加質量効果を考慮した最

適カット角は、Li TaO3 基板の場合、40°Y~4 4°Yの範囲、またLiNbO3 基板の場合には、66 。 Y~74° Yの範囲となる。

【0022】また、SAWフィルタ11において、櫛形 電極11A~11CとしてAlを主成分とする電極を使 った場合、かかる付加質量効果は、電極の厚さが励起さ れる弾性表面波の波長の5~10%の範囲にある場合に 顕著に現れる。またLiNbOs基板を使う場合には、 付加質量効果は、前記Al系櫛形電極の厚さが励起され る弾性表面波波長の4~12%の範囲にある場合に顕著 に現れる。

【0023】次に、本発明の第2実施例を、図5を参照 しながら説明する。ただし、図5中、先に説明した部分 に対応する部分には同一の参照符号を付し、説明を省略 する。図5を参照するに、本実施例によるSAWフィル タは、前記第1実施例と同様な42°Y-XLiTaO 3 基板1上に構成され、前記図19あるいは図1に示し たのと同様な、X軸方向に整列した反射器10A, 10 B、および反射器10A, 10B間に順次配列された櫛 形電極11A, 11B, 11CよりなるSAWフィルタ 11と、同じ基板1上に構成され、X軸方向に整列した 反射器20A, 20B、および反射器20A, 20B間 に順次配列された櫛形電極21A, 21B, 21Cより なるSAWフィルタ21とを含み、SAWフィルタ11 とSAWフィルタ21とは、櫛形電極11Bを構成する 2次側電極 (11B) 2 を櫛形電極21Bを構成する1 次側電極 (21B) 2 に接続することにより、カスケー ド接続される。ただし、本実施例によるSAWフィルタ では、SAWフィルタ11の電極対数N1, N2, N3 の間には、先の実施例のようにN₁ ≠ N₃ ≠ N₂ の関係 30 が成立してもよいが、この関係は必ずしも成立する必要 はない。

【0024】図5の実施例では、櫛形電極11A, 11 Cの1次側電極 (11A) 1, (11C) 1 が共通に入 力電極パッドに接続され、また櫛型電極11A, 11C の2次側電極 (11A)₂, (11B)₁、および櫛形 電極11Bの1次側電極 (11B) 1 は接地されてい る。すなわち、SAWフィルタ11は2入力1出力型の フィルタを構成する。これに対し、SAWフィルタ21 では、櫛形電極21A, 21Cの2次側電極 (21A) 2, (21C)₂ が共通に出力電極パッドに接続され、 また櫛型電極21A, 21Cの1次側電極(21 A) 1 , (21C) 1 、および櫛形電極21Bの2次側 電極 (21B)₂ は接地されている。すなわち、SAW フィルタ21は1入力2出力型のフィルタを構成する。 【0025】図5の実施例では、SAWフィルタ11の 電極交差幅がW₁ であるのに対し、SAWフィルタ21 の電極交差幅がW₂ (≠W₁)とされ、その結果、SA Wフィルタ全体の入力インピーダンスと出力インピーダ 12

ィルタ全体の入力インピーダンスは、電極交差幅がWi のSAWフィルタ11の入力インピーダンスで決定され るのに対し、全体の出力インピーダンスは、電極交差幅 がW₂のSAWフィルタ21の出力インピーダンスで決 定される。

【0026】先にも説明したように、SAWフィルタの 入出力インピーダンスは電極対数と電極交差幅に反比例 するが、電極対数はフィルタの通過帯域特性を決定する ため、自在に選択することはできない。これに対し、電 10 極交差幅は、フィルタの通過帯域特性とは無関係に設定 できるため、図5の実施例では、電極交差幅W1 と電極 交差幅W2 とを独立に設定することにより、SAWフィ ルタ1の入力インピーダンスとSAWフィルタ2の出力 インピーダンスとを、独立かつ自在に変化させている。 【0027】図6は、図5のSAWフィルタの一変形例 を示す。ただし、図6中、先に説明した部分には同一の 参照符号を付し、説明を省略する。図6を参照するに、 櫛形電極11Bの1次側電極 (11B) n が入力電極パ ッドに接続され、一方電極11Bの2次側電極(11 B) 2 は接地される。これに対し、櫛形電極11A, 1 1 C の 1 次側電極 (1 1 A), (1 1 C), は接地さ れ、2次側電極 (11A) 2, (11C) 2は、それぞ れ櫛形電極21Aの1次側電極(21A) i および櫛形 電極21Cの1次側電極(21C)1 に接続される。す なわち、SAWフィルタ11は、図6の実施例では1入 力2出力型の構成を有する。

【0028】一方、SAWフィルタ21では、前記櫛形 電極21A, 21Cの2次側電極 (21A) 2, (21 C) 2 が接地され、また櫛形電極21Bの1次側電極 (21B) / が接地される。その際、出力は、前記櫛形 電極21Bの2次側電極 (21B) 2 から得られる。す なわち、SAWフィルタ21は2入力1出力の構成を有

【0029】図6のSAWフィルタにおいても、フィル タ全体の入力インピーダンスとフィルタ全体の出力イン ピーダンスを、SAWフィルタ11の電極交差幅W₁と SAWフィルタ21の電極交差幅W₂とを、互いに独立 に設定することで、所望の設計値にあわせて自在に設定 することができる。

【0030】図7は、図5のSAWフィルタのさらに別 の実施例を示す。ただし、図7中、先に説明した部分に は同一の参照符号を付し、説明を省略する。図7を参照 するに、本実施例では、SAWフィルタ11は、図5の 実施例と同様な1入力2出力の構成を有する。また、S AWフィルタ21も、SAWフィルタ11と同様な2入 力1出力の構成を有する。すなわち、櫛形電極11A, 11Cの1次側電極 (11A) 1, (11C) 1 が共通 に入力電極パッドに接続され、また櫛型電極11A, 1 1 C の 2 次側電極 (11A) 2 , (11B) + 、および ンスとが異なった値に設定される。すなわち、SAWフ 50 櫛形電極11Bの1次側電極(11B): は接地されて

40

いる。同様に、SAWフィルタ 21 でも、櫛形電極 21 A, 21 Cの 1 次側電極(21 A) $_1$, (21 C) $_2$ が 共通に櫛形電極 11 Bの 2 次側電極(11 B) $_2$ に接続され、2 次側電極(21 A) $_2$, (21 C) $_2$ が接地、櫛形電極 21 Bの 2 次側電極(21 B) $_2$ が出力電極パッドに接続されている。すなわち、図 7 の構成では、二つの 1 入力 2 出力型 SAWフィルタ 11 , 21 が、カスケード接続される。

【0031】図7のSAWフィルタでは、SAWフィルタ11とSAW21との接続部における損失を最小化す 10 るために、SAWフィルタ11の出力インピーダンスと SAWフィルタ21の入力インピーダンスとを整合させている。すなわち、SAWフィルタ11の入力インピーダンスを21、出力インピーダンスを22、SAWフィルタ21の入力インピーダンスを23、出力インピーダンスを24として、一般に関係式

 $Z_1 : Z_2 = Z_3 : Z_4$

が成立するが、本実施例では、前記インピーダンス整合を達成するため、前記電極交差幅 W_1 , W_2 は、関係式 $Z_2=Z_3$

が成立するように設定される。

【0032】その結果、Z₁, Z₂, Z₃, Z₄ の間に は、関係式

 $Z_2 = Z_3 = \sqrt{(Z_1 \times Z_4)}$

が成立する。図7の構成のSAWフィルタでは、例えば SAWフィルタ11の電極交差幅W₁ を601、SAW フィルタ21の電極交差幅W₂ を351とし、SAWフィルタ11、21の電極対数N₁、N₂、N₃を、

 $N_1:N_2:N_3=15:21:15$ に設定する。ただし、 λ は圧電基板上に励起される弾性表面波の波長であり、約4. 3μ mの値を有する。この場合、SAWフィルタ11の入力インピーダンス、すなわちSAWフィルタ全体の入力インピーダンスは50 Ω 、SAWフィルタ 21の出力インピーダンス、すなわちSAWフィルタ全体の出力インピーダンスは150 Ω となる。

【0033】図7のSAWフィルタでは、SAWフィルタ11と21との間にインピーダンス整合が成立しているため、これを多段カスケード接続することが可能であるが、その場合には、入力インピーダンスと出力インピーダンスの差をさらに大きくすることが可能である。

【0034】また、このような多段接続されたSAWフィルタでは、通過帯域レベルに対して通過帯域外レベルを、単一段よりなるSAWフィルタに比べて効果的に抑圧することが可能である。図8は、図7のSAWフィルタの周波数特性を、入力側を50Ωの抵抗で終端し、出力側を150Ωの抵抗で終端した場合について示す。

【0035】図8を参照するに、かかるSAWフィルタを多段接続した構成により、通過帯域外のスプリアスピークが、効果的に抑圧されていることがわかる。すなわち、本実施例によるSAWフィルタにより、図1~3で

説明したSAWフィルタと同様な、スプリアスピークの 抑圧が可能になり、SAWフィルタの周波数特性が向上 する。

【0036】図9は本発明の第3実施例によるSAWフィルタの構成を示す。ただし、図9中、先に説明した部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。本実施例では、単一のSAWフィルタにおいて、出力インピーダンスの値を入力インピーダンスの値に対して変化させる。

【0037】図9を参照するに、櫛形電極11Bの1次側電極(11B)」は第1の入力電極パッドに接続され、さらに2次側電極(11B)2は第2の入力電極パッドに接続される。すなわち、図9のSAWフィルタは、前記第1および第2の入力電極パッドに別個の入力信号を供給した場合、いわゆる差動型のフィルタを構成する。また、従来のように、電極(11B)2を接地してもよい。

【0038】さらに、図9のSAWフィルタでは、櫛形電極11Aの2次側電極(11A)2と櫛形電極11Cの2次側電極(11C)2とが接続され、さらに櫛形電極11Aの1次側電極(11A),が第1の出力端子に、櫛形電極11Cの1次側電極(11C),が第2の出力端子に接続される。換言すると、櫛形電極11Aと櫛形電極11Cとはカスケード接続される。また、前記電極(11A),または電極(11C),を接地してもよい。

【0039】図9の構成では、櫛形電極11A~11Cは、いずれも同一の電極交差幅Wを有するが、出力電極を構成する櫛形電極11Aおよび11Cがカスケード接続されるため、SAWフィルタの出力インピーダンスは、櫛形電極11Aの出力インピーダンスZ1と櫛形電極11Cの出力インピーダンスZ3の和になる。すなわち、図9の構成では、SAWフィルタの出力インピーダンスを、入力インピーダンスZ2に対して、完全に自在にではないが、増大あるいは減少させることが可能である。ただし、入力インピーダンスZ2は、櫛形電極11Bの入力インピーダンスZ2に等しい。

【0040】図10は、本発明の第4実施例によるSAWフィルタの、パッケージを含む構成を示す。ただし、40先に説明した部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。図10を参照するに、図5に示した構成のSAWフィルタを担持する圧電基板1がセラミックパッケージ基板100上には第1の側に接地電極101および103が、入力電極102を両側から挟持するように形成される。また、前記パッケージ基板100は、第2の側に、別の接地電極104および106が、出力電極105を両側から挟持するように形成される。

ークが、効果的に抑圧されていることがわかる。すなわ 【0041】図10の構成では、圧電基板1上のSAW ち、本実施例によるSAWフィルタにより、図1~3で 50 フィルタ11のうち、櫛形電極11Aの接地電極(図5

の電極 (11A) 2) はパッケージ100上の前記接地電極101に、A1ワイヤ107で接続され、櫛形電極11Cの接地電極(図5の電極(11C) 2) は、パッケージ100上の前記接地電極103に、別のA1ワイヤ107で接続される。さらに、櫛形電極11Bの接地電極(図5の電極(11B)))は、前記接地電極103に、別のA1ワイヤ107により接続される。一方、前記櫛形電極11A,11Cの出力電極(図5の電極(11A)),(11C),は、共通に、前記接地電極101と103の間に配設された入力電極102に、別のA1ワイヤ107により接続される。

【0042】これに対し、圧電基板1上のSAWフィル タ21のうち、櫛形電極21Aの接地電極 (図5の電極 (21A),) はパッケージ100上の前記接地電極1 04に、別のA1ワイヤ107で接続され、櫛形電極2 1 Cの接地電極 (図 5 の電極 (2 1 C) 2) は、パッケ ージ100上の前記接地電極103に、別のAIワイヤ 107で接続される。さらに、櫛形電極21Bの接地電 極(図5の電極(21B)2)は、前記接地電極104 に、別のA1ワイヤ107により接続される。一方、前 記櫛形電極21A,21Cの出力電極(図5の電極(2 1A)₂, (21C)₂ は、共通に、前記接地電極10 4と106の間に配設された入力電極105に、別のA 1ワイヤ107により接続される。また、SAWフィル タ11とSAWフィルタ21とは、櫛形電極11Bの2 次側電極(11B)2 を櫛形電極21Bの1次側電極 (21B), に接続することにより、カスケード接続さ

【0043】一般にセラミックパッケージ上に形成された電極相互間では容量結合が形成されるのが避けられないが、本実施例の構成では、入力側の接地電極101,103に対して出力側の接地電極104,106を、パッケージの対向縁部に形成することにより、このような接地電極が相互に干渉してSAWフィルタの選択特性が劣化する問題が回避される。また、図10の構成では入力側、出力側のそれぞれにおいて、接地電極、例えは電極101と103、あるいは電極104と106を独立させ、相互干渉を回避している。

【0044】図11は、図10の構成のSAWフィルタの通過帯域特性を、図10の構成において、SAWフィルタ11および21の接地接続を、入力側接地電極101,103および出力側接地電極104,106とで入れ換えた場合と比較して示す。

【0045】図11中、特性Bは図10の構成のSAWフィルタの通過帯域特性を、一方特性Aは、前記フィルタ11を構成する櫛形電極11A,11Cの2次側電極(11A)2,(11C)2をそれぞれ接地電極101および104にAlワイヤにより接続した場合に対応する。

【0046】図11よりわかるように、図10の構成を

使うことにより、SAWフィルタの通過帯域外レベルが 著しく改善される。逆に、特性Aでは、かかる接地電極 間の干渉により帯域外レベルが低下してしまう。ところ で、このような、パッケージも含めたSAWフィルタの

16

構成においては、入力側接地電極出力側接地電極との干渉を回避するように、SAWフィルタを保護する金属キャップの構成についても改良が要求される。

【0047】図12は、本発明の第5実施例による、図 10のSAWフィルタの金属キャップまで含めた構成を 示す分解図である。図12を参照するに、パッケージ本 体100は、ベース100Aとベース100A上に形成 された電極保持部100Bとよりなり、さらにかかるパ ッケージ本体100上にスペーサ110を介して金属キ ャップ120が設けられる。ベース100Aは、四隅に カット100A1, 100A2, 100A3 および10 OA4 を形成され、また上主面上に接地電極100Gが 形成される。さらに、前記接地電極100Gには、パッ ケージ100の出力側縁部に電極リード100Gaおよ び100Gbが形成され、電極リード100Gaおよび 100Gbからは、ベース100Aの側壁面上を電極リ ード100gaおよび100gbが、ぞれぞれ接地電極 リードとして延在する。同様に、パッケージ100の入 力側縁部には電極リード100Gcおよび100Gdが 形成され、電極リード100Gcおよび100Gdから は、ベース100Aの側壁面上を電極リード100gc および100gdが、ぞれぞれ接地電極リードとして延 在する。

【0048】前記ベース100A上にはSAWフィルタを担持する圧電基板1が保持され、また同じベース100A上には前記電極保持部100Bが設けられる。その際、電極保持部100Bには中央部にベース100A上の接地電極100Gを露出する開口部が形成され、前記圧電基板1はかかる開口部を介して前記接地電極100Gに接着される。

【0049】電極保持部100Bは四隅にそれぞれ前記カット100A1~100A4に対応するカット100B1~100B4を形成され、電極101~103は、電極保持部100Bの上主面上に、入力側縁部に沿って形成される。また、電極104~106は出力側縁部に沿って形成される。電極104~106からは、それぞれ電極リード104a,105a,106aが、電極保持部100Bの出力側側壁面上を延在し、電極リード100gaに接続する。同様に、電極リード106aはベース100A側壁面上の電極リード100gbに接続する。さらに、電極リード105aは、ベース100A側壁面上の電極リード105aは、ベース100A側壁面上の電極リード105aは、ベース100A側壁面上の電極リード105aは、ベース100A側壁面上の電極リード105aは、ベース100A側壁面上の電極リード105aは、ベース100A側壁面上の電極リード105aは、ベース100A側壁面上の電極リード105aは、ベース100A側壁面上の電極リードが、入力側縁部に沿った電極101~103についても形成される。

【0050】一方、スペーサ110は前記電極101~

50

30

18

106の一部および圧電基板1を露出するリング状の構成を有し、四隅にはそれぞれ前記カット100B₁ ~100B₄ に対応するカット110₁ ~110₄ が形成される。また、スペーサ110の上主面上には接地電極110Aが形成され、前記金属キャップ120はかかる接地電極110A上にロウ付けされる。

【0051】その際、前記カット110」を構成するスペーサ110の側壁面上には、接地電極110Aから延在する電極リードが形成され、かかるカット110」上の電極リードは、スペーサ110を電極保持部100B上に装着する際、前記電極保持部100B上において前記接地電極104からカット100B」に向かって延在する電極リード104a」に接続される。換言すると、前記金属キャップ120は、前記接地電極104にのみ電気的に接続され、他の接地電極101,103あるいは106には接続されない。その結果、図11で説明した接地電極相互間の干渉によるSAWフィルタの通過帯域特性の劣化が生じるのを回避することができる。

【0052】図13は、図12のSAWフィルタの通過 帯域特性を示す。図13を参照するに、特性Bは図12のSAWフィルタのものを、一方特性Aは図12において、金属キャップ120をその四隅全てにおいて接地した場合を示す。図12よりわかるように、金属キャップ120を四隅全てにおいて接地した場合、一か所のみで接地した場合に対して通過帯域外レベルが著しく上昇してしまう。これば、複数の接地電極が、前記金属キャップ120を介して相互作用していることを示す。

【0053】図14は、本発明の第6実施例によるSA Wフィルタの、パッケージまで含めた構成を示す図であ る。ただし、図14の実施例は図10の実施例の変形で あり、図14中、先に説明した部分には同一の参照符号 を付し、説明を省略する。図14を参照するに、本実施 例では、図10と同じパッケージ100上に、前記SA Wフィルタ11 (または21) のみを担持した圧電基板 1が設けられる。この場合、出力側櫛形電極11A, 1 1 Cの接地は、出力側接地電極104,106におい て、また入力側櫛形電極11Bの接地は、入力側接地電 極101においてとられる。ただし、図14の構成で は、接地電極101にも入力信号が供給され、その結 果、SAWフィルタは差動型フィルタとして動作する。 【0054】かかる構成においても、入力側接地電極と 出力側接地電極との間の容量結合が抑制され、その結果 図10あるいは図12に示したのと同様な優れた帯域外 減衰特性が得られる。図15は、本発明の第7実施例に よるSAWフィルタの構成を示す図である。ただし、先 に説明した部分は同じ参照符号で示し、説明を省略す る。

【0055】先に説明した図14のSAWフィルタは、 接地電極にも入力信号を供給することにより差動型のフィルタとして動作するが、本実施例によるSAWフィル

【0056】図15の構成においても、図1の構成と同様に、電極対数 N_1 , N_2 , N_3 が非対称に設定されている($N_1 \neq N_3 \neq N_2$)。図16は本実施例の別の変形例であり、図5の構成のSAWフィルタを作動型に変形したものである。ただし、図16中、先に説明した部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。

【0057】図16を参照するに、櫛形電極11A,11Cのそれぞれの2次側電極(11A)2,(11C)202には、1次側電極(11A)1,(11C)1に供給される入力信号In1とは別の入力信号In2が共通に供給され、また櫛形電極21A,21Cのそれぞれの1次側電極(21)A1,(21C)1からは、2次側電極(21A)2,(21C)2から出力される出力信号Out1とは別の出力信号Out2が得られる。

【0058】図5の構成と同様に、図16の構成においても、SAWフィルタ11の電極交差幅W1とSAWフィルタ21の電極交差幅W2とは異なった大きさを有する。さらに、図17および18の構成は、それぞれ図630および図7のSAWフィルタを差動型に変形した例を示す。これらの例においても、接地電極に図6あるいは図7で使われた入力信号In1とは別の入力信号In2を供給し、あるいは接地電極から図6あるいは図7の出力信号Out1とは別の出力信号Out2を取り出すことにより、SAWフィルタを差動型フィルタとして動作させることができる。図17,18の構成は先の説明より明らかであり、説明を省略する。ただし、図15~18の構成では、SAWフィルタを入力端子および出力端子の双方についてき動型に構成したが、入力端子および出力端子の一方についてのみ差動型に構成してもよい。

【0059】以上の各実施例において、圧電基板1として、第1実施例の場合と同様に、LiTaOs あるいはLiNbOs の単結晶を、LiTaOs の場合40°Y~44°Yの範囲の回転角で、またLiNbOs の場合66°Y~74°Yの範囲の回転角でカットした、回転Y板を使うのが好ましい。また、その際、圧電基板上に形成される櫛形電極は、圧電基板としてLiTaOs を使う場合、圧電基板上に励起される弾性表面液の波長の5~10%の範囲の厚さのAlあるいはAl合金により 50 構成するのが好ましい。圧電基板としてLiNbOs を

使う場合には、櫛形電極を、励起弾性表面波の波長の4~12%の範囲の圧だのAlあるいはAl合金により構成するのが好ましい。

[0060]

【発明の効果】請求項1および4~7、あるいは14記載の本発明の特徴によれば、弾性表面波装置を、圧電基板上に共通に形成された少なくとも第1および第2の弾性表面波装置要素を含むように構成し、前記第1の弾性表面波装置要素を前記第2の弾性表面波装置要素にカスケード接続し、その際前記第1の弾性表面波装置要素の電極交差幅を、前記第2の弾性表面波装置要素の電極交差幅に対して変化させることにより、前記第1および第2の弾性表面波装置要素を含む弾性表面波装置の入力インピーダンスと出力インピーダンスとを、自在に設定することが可能になる。

【0061】請求項2または3記載の本発明の特徴によれば、かかる共通の圧電基板上において第1の弾性表面 波装置要素と第2の弾性表面波装置要素とをカスケード接続した弾性表面波装置において、それぞれの電極交差 幅を、前記第1の弾性表面波装置要素の出力インピーダンスと前記第2の弾性表面波装置要素の入力インピーダンスとが整合するように設定すれることにより、インピーダンスの不整合に伴う損失を最小化することが可能に なる。

【0062】請求項8記載の本発明の特徴によれば、前記第1および第2の弾性表面波装置要素の各々をいわゆる二重モード型フィルタとして構成し、弾性表面波の経路に沿って配設された第1、第2および第3の櫛形電極を、それぞれ互いに異なる第1,第2および第3の電極対数を有するように形成することにより、通過帯域外のスプリアスピークを効果的に抑圧することが可能になる。

【0063】請求項9~11記載の本発明の特徴によれば、圧電基板を支持するパッケージと、前記圧電基板上に形成された少なくとも一つの弾性表面波装置要素とよりなる弾性表面波装置において、前記圧電基板上に、弾性表面波の伝搬経路に沿って形成された複数の櫛形電極中に含まれる入力側櫛形電極を、前記パッケージ上に設けられた第1の接地電極パッドに接続し、また前記複数の櫛形電極中に含まれる出力側櫛形電極を、前記パッケージ上に、好ましくは反対側に設けられた第2の別の接地電極パッドに接続することにより、接地電極相互間の干渉が回避され、その結果、フィルタの通過帯域特性が向上する。

【0064】請求項12,13記載の本発明によれば、 圧電基板上に弾性表面波の伝搬経路に沿って順次配設された第1,第2および第3の櫛形電極を含む二重モード 型弾性表面波装置において、前記第1の櫛形電極の電極 対数を、前記第3の櫛形電極の電極対数に対して変化させることにより、通過帯域外におけるスプリアスピーク を実質的に抑圧することが可能である。

【0065】請求項15,16記載の本発明によれば、前記圧電基板を、回転角が40°Y~44°YのLiTaO3 単結晶の回転Y板、あるいは回転角が66°Y~74°YのLiNbO3 単結晶の回転Y板により形成し、櫛形電極をAlを主成分とする材料により、圧電基板が前記LiTaO3 基板の場合、圧電基板上に励起される弾性表面波の波長の5~10%の範囲の厚さに、また圧電基板がLiNbO3 の場合、圧電基板上に励起される弾性表面波の波長の4~12%の厚さに形成することにより、電極の付加質量が顕著に現れる超高周波帯域においても、フィルタの損失を最小限に止めることが可能になる。

20

【0066】請求項17記載の本発明の特徴によれば、複数の電極指を有する1次側電極と、前記1次側電極指の複数の電極指に対して交互に配列された別の複数の電極指を有する2次側電極とよりなる複数の櫛形電極を、弾性表面波の経路の沿って配列した弾性表面波装置において、1次側電極が入/出力端子に接続された櫛形電極の2次側電極を、別の入/出力端子に接続することにより、非常に簡単な構成で、差動型のSAWフィルタを形成することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理、および本発明の第1実施例によるSAWフィルタの構成を示す図である。

【図2】計算で求められた図3のSAWフィルタの周波 数特性を、図19のフィルタ特性と比較して示す図である。

【図3】図1のSAWフィルタの実際の周波数特性を、 30 図19のSAWフィルタの実際の周波数特性と比較して 示す図である。

【図4】図19のSAWフィルタの実際の周波数特性を示す図である。

【図5】本発明の第2実施例によるSAWフィルタの構成を示す図である。

【図6】図5のSAWフィルタの変形例を示す図である。

【図7】図5のSAWフィルタの別の変形例を示す図である。

7 【図8】図7のSAWフィルタの周波数特性を示す図である。

【図9】本発明の第3実施例によるSAWフィルタの構成を示す図である。

【図10】本発明の第4実施例によるSAWフィルタの 構成を示す図である。

【図11】図10のSAWフィルタの周波数特性を示す 図である。

【図12】図10のSAWフィルタの構成を、金属キャップまで含めて示す本発明の第5実施例による分解図で ある。

【図13】図12のSAWフィルタの周波数特性を示す 図である。

【図14】本発明の第6実施例によるSAWフィルタの 構成を示す図である。

【図15】本発明の第7実施例によるSAWフィルタの 構成を示す図である。

【図16】本発明第7実施例の一変形例を示す図であ ろ。

【図17】本発明第7実施例の別の変形例を示す図である。

【図18】本発明第7実施例のさらに別の変形例を示す 図である。

【図19】(A), (B)は、従来の二重モード型SAWフィルタの構成および動作原理を説明する図である。

【図20】図19のSAWフィルタの計算で求められた 周波数特性を示す図である。

【符号の説明】

1, 圧電基板

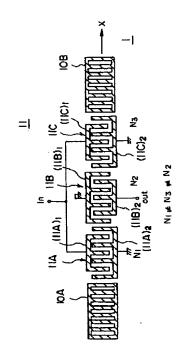
10A, 10B, 20A, 20B 反射器

11, 21 SAWフィルタ

11A, 11B, 11C, 21A, 21B, 21C 櫛 形電極

【図1】

本発明の原理、および本発明の第1実施例による SAWフィルタの構成を示す図



22

(11A), (11B), (11C), (21A), (21B), (21C), 1次側電極 (11A), (21B), (11C), (21A), (21B), (21C), 2次側電極 100 パッケージ基板

100A ベース

 $1\,0\,0\,A_1$, $1\,0\,0\,A_2$, $1\,0\,0\,A_3$, $1\,0\,0\,A_4$, $1\,0\,0\,B_1$, $1\,0\,0\,B_2$, $1\,0\,0\,B_3$, $1\,0\,0\,B_4$, $1\,1\,0_1$, $1\,1\,0_2$, $1\,1\,0_3$, $1\,1\,0_4$ カット面

10 100B 電極保持部

100G, 110A 接地電極

100Ga, 100Gb, 100Gc, 100Gd 接 地電極リード

101, 103, 104, 106 接地端子電極

104a, 105a, 106a 電極リード

102 入力端子電極

105 出力端子電極

107 AlD/17

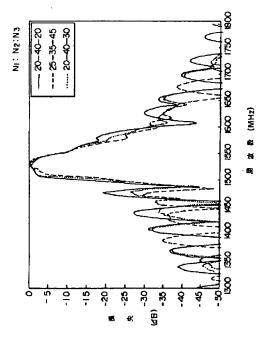
107a 導体パターン

20 110 スペーサ

120 金属電極

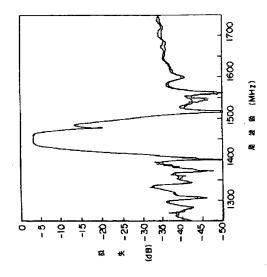
【図2】

図1のSAWフィルタの計算で求められた周波数特性 を示す図



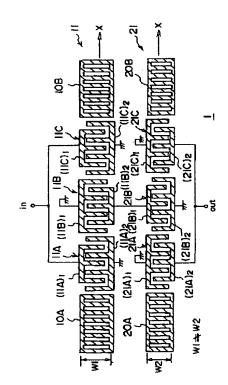
【図3】

本発明の原理、および本発明の第1実施例による S A W フィルタの特性を示す図



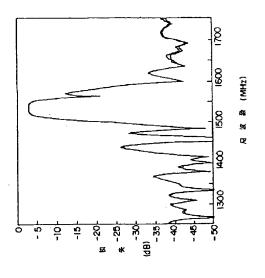
【図5】

本発明の第2実施例によるSAWフィルタの構成を示す図



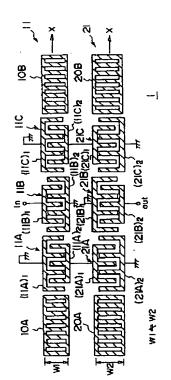
【図4】

図1905AWフィルタの実際の周波敷特性を示す図



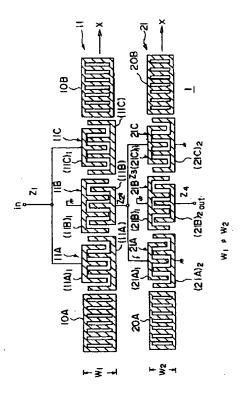
【図6】

図5のSAWフィルタの変形例を示す図



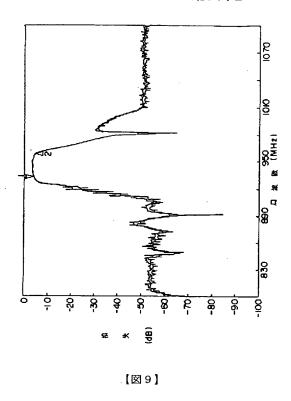
【図7】

図5のSAWフィルタの別の変形例を示す図

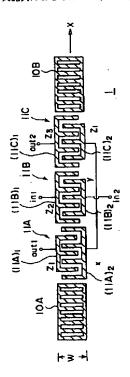


【図8】

図1のSAWフィルタの周波数特性を示す図

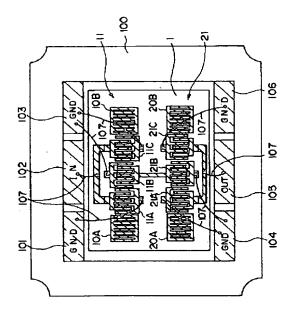


本発明の第3実施例によるSAWフィルタの構成を示す図



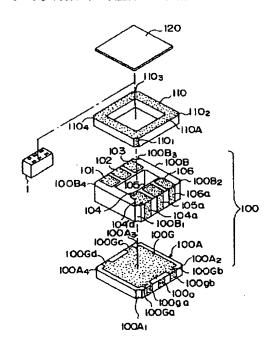
【図10】

本発明の第4実施例による8AWフィルタの存成を示す図



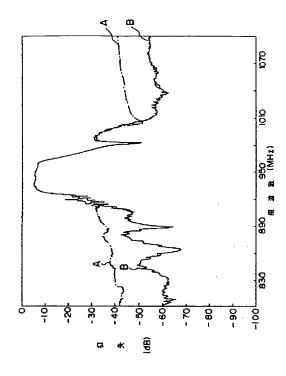
【図12】

図10の8AWフィルタの椴成を、金属キャップまで含めて示す本発明の第5実施例による分帰図



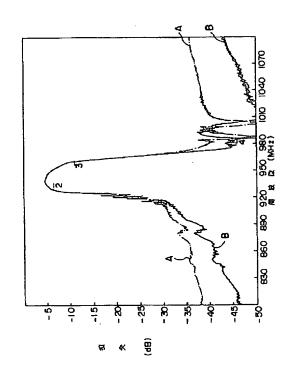
【図11】

図10のSAWフィルタの周波数特性を示す図



【図13】

図12のSAWフィルタの周波数特性を示す図

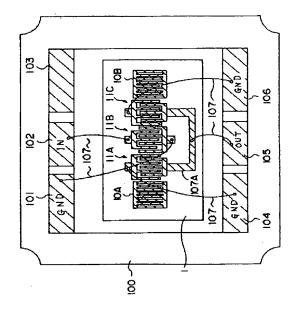


【図14】

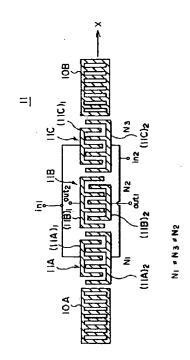
本発明の餌6実施例によるSAWフィルタの構成を示す図

【図15】

本発明の第1実施例によるSAWフィルタの構成を示す図



[図16]



【図20】

本発明節 7 実施例の一変形例を示す図

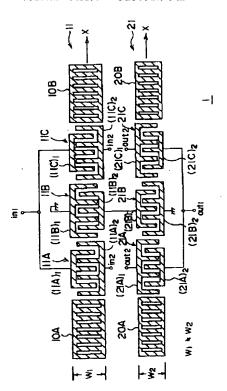
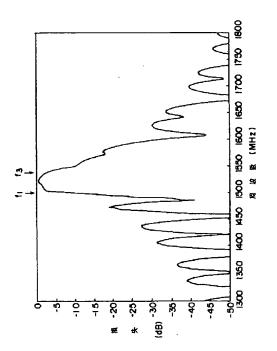
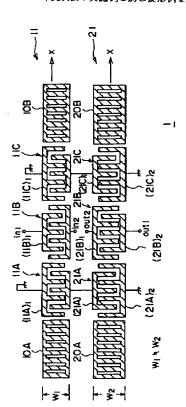


図1のSAWフィルタの計算で求められた周波数特性 を示す図



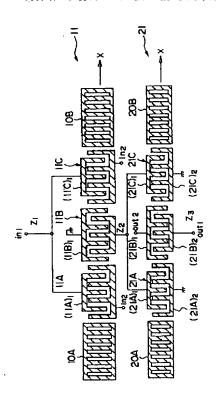
【図17】

本発明第7奥施例の別の変形例を示す図



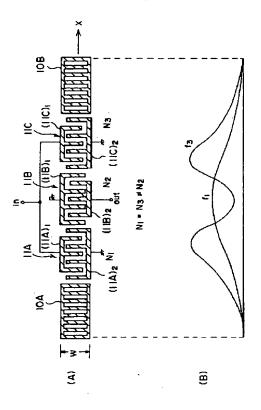
【図18】

本発明第7実施例のさらに別の変形例を示す図



【図19】

(A) , (B)は、従来の二重モード型SAWフィルタの 構成および動作原理を説明する図



フロントページの続き

(72) 発明者 川内 治

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内 (72)発明者 藤原 嘉朗

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内